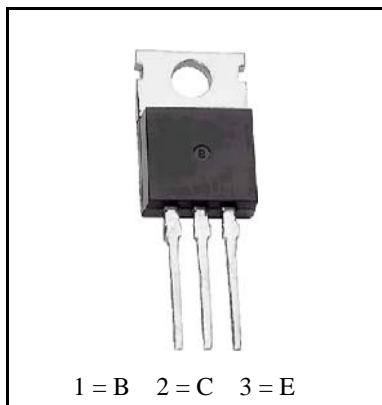


NPN

Si-Epitaxial Planar Transistors

NPN

Version 2004-06-29



Collector current – Kollektorstrom 3 A

Plastic case TO-220AB
Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca. 2.2 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging in tubes
Standard Lieferform in StangenMaximum ratings ($T_A = 25^\circ\text{C}$)Grenzwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

			TIP31	TIP31A	TIP31B	TIP31C
Collector-Emitter-voltage	B open	V_{CE0}	40 V	60 V	80 V	100 V
Collector-Emitter-voltage	B shorted	V_{CES}	40 V	60 V	80 V	100 V
Emitter-Base-voltage	C open	V_{EB0}	5 V			
Power dissipation – Verlustleistung						
without cooling – ohne Kühlung		P_{tot}	2 W ¹⁾			
with cooling – mit Kühlung	$T_C = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	40 W			
Collector current – Kollektorstrom		I_C	3 A (dc)			
Peak Collector current Kollektor-Spitzenstrom		I_{CM}	5 A			
Base current – Basisstrom		I_B	1 A			
Junction temp. – Sperrschichttemp.		T_j	150°C			
Storage temp. – Lagerungstemperatur		T_s	- 65...+ 150°C			

Characteristics, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Kennwerte, $T_j = 25^\circ\text{C}$

		Min.	Typ.	Max.
Collector saturation volt. – Kollektor-Sättigungsspannung				
$I_C = 3\text{ A}, I_B = 375\text{ mA}$	V_{CEsat}	–	–	1.2 V
Base-Emitter voltage – Basis-Emitter-Spannung				
$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 3\text{ A}$	$-V_{BEon}$	–	–	1.8
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis				
$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 1\text{ A}$	h_{FE}	25	–	–
$V_{CE} = 4\text{ V}, I_C = 3\text{ A}$	h_{FE}	10	–	50

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics ($T_j = 25^\circ\text{C}$)Kennwerte ($T_j = 25^\circ\text{C}$)

			Min.	Typ.	Max.
Collector-Emitter cutoff current – Kollektorreststrom					
$V_{CE} = 30\text{ V}$	TIP31	I_{CE0}	–	–	300 nA
	TIP31A	I_{CE0}	–	–	300 nA
$V_{CE} = 60\text{ V}$	TIP31B	I_{CE0}	–	–	300 nA
	TIP31C	I_{CE0}	–	–	300 nA
$V_{CE} = \text{rated } V_{CE0}$		I_{CES}	–	–	200 nA
h-Parameters at $V_{CE} = 10\text{ V}$, $I_C = 0.5\text{ A}$, $f = 1\text{ kHz}$					
Small signal current gain Kleinsignal-Stromverstärkung		h_{fe}	20	–	–
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz					
$V_{CE} = 10\text{ V}$, $I_C = 0.5\text{ A}$, $f = 1\text{ MHz}$		f_T	3 MHz	–	–
Switching times – Schaltzeiten					
turn-on time	$I_{Con} = 1\text{ A}$, $I_{Bon} = -I_{Boff} = 100\text{ mA}$	t_{on}	–	300 ns	–
turn-off time		t_{off}	–	1 μs	–
Thermal resistance – Wärmewiderstand					
junction to ambient air – Sperrschicht zu umgebender Luft				R_{thA}	62 K/W ¹⁾
junction to case – Sperrschicht zu Gehäuse				R_{thC}	3 K/W
Admissible torque for mounting Zulässiges Anzugsdrehmoment				M 4	$9 \pm 10\%$ lb.in. $1 \pm 10\%$ Nm
Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren				TIP32, TIP32A TIP32B, TIP32C	

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 5 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden